

# 電磁波散乱に対する遂次伝達法の基礎検討

加藤 初弘<sup>†a)</sup> 木谷 昌経<sup>†</sup> 加藤 初儀<sup>††</sup>

Recursive Transfer Method as an Accurate Numerical Method to Analyze the Scattering of the Electromagnetic Wave

Hatsuhiro KATO<sup>†a)</sup>, Masanori KITANI<sup>†</sup>, and Hatsuyoshi KATO<sup>††</sup>

あらまし 逐次伝達法は,電子波に関して開発された方法であるが,波動の伝搬を逐次伝達行列により表現す ることで境界条件を一般化できる汎用性の高い数値計算法である.ここでは,電磁波散乱に関する定式化の詳細 をまとめるとともに,導波管に設置されたスリットによるマイクロ波の透過率を解析することで,この方法の有 効性を実証的に検討する.

キーワード 逐次伝達法,散乱,透過率,数値計算法

# 1. まえがき

マイクロ波や光の散乱を取扱う数値計算法として, 有限要素法 (FEM),有限差分時間領域法 (FDTD), ビーム伝搬法 (BMP) やこれらを融合させる工夫が数 多くなされている [1],[2].これらの中で,反射・透過 を取り扱い可能な方法として,双方向固有モード伝 搬法 (BEP) [3],FFT-BPM [4] やフーリエ級数展開 法 [5],[6] などが論じられているが,散乱体が複雑な形 状の場合,伝搬軸の各点においてモード解析を実施し なければならない.

逐次伝達法は,電極間の電子伝導に関して開発され た数値計算法であるが[7],[8],システムの空間的な構 成を散乱ポテンシャルにより考慮できる汎用性の高い 方法である.この方法の特徴は,状態変数として波の 振幅の代わりに逐次伝達行列を用いることである.出 力端での境界条件を逐次伝達行列で表現すると,その 表現には波の振幅やモードの重ね合わせの情報を顕わ に含んでいない.したがって,出力境界においてエネ ルギー流束を担わないモードも含めて多数のモードが 存在している場合でも,境界条件の表現が簡潔であり 特別な処理を必要としない.更に,この方法では散乱 体内の各点におけるモード解析も不要である.

逐次伝達法で使用する差分方程式の安定性に対して も詳細な検討があり [9], [10],解の安定性が保証され ている.また,散乱体によりエネルギー流束を担わな い局在波が引き起こされたとしても,これらを除いて エネルギー流束を求めることができるので,複雑な形 状によるエネルギー吸収の解析も可能である [11].

筆者はマイクロ波への適用を前提として,逐次伝達 法の基礎的な検討を始めている[12].ここでは,導波 管内に設置されたスリットを通過する散乱波の透過率 に関する解析を例として,定式化の詳細を論じる.更 に,この理論により数値的に得た透過率を計測値と比 較することにより,実証的な検討を行う.本論文で提 案しているフーリエ展開の基底関数に横方向の波数 k<sub>x</sub> を含む展開方法は,平面波が座標軸に対して斜めに入 射している状況を効率的に表現できる方法である.導 波管内のモードが平面波の重ね合わせとみなし得るこ とから,この展開法は導波管内での散乱現象にも利用 できる適用範囲の広い方法である.

2. 逐次伝達法のマイクロ波散乱への適用

2.1 システムの構成 導波管における散乱現象は,入射・反射・透過の各

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> 山梨大学大学院医学工学総合研究部,甲府市 Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi, 4–3–11 Takeda, Kofu-shi, 500– 8511 Japan

<sup>&</sup>lt;sup>††</sup> 苫小牧工業高等専門学校,苫小牧市 Tomakomai National College of Technology, 433 Nishikioka, Tomakomai-shi, 059–1275 Japan

a) E-mail: katoh@yamanashi.ac.jp



Fig. 1 Structure of experiment system.

波動を高い精度で計測できるので,図1に示したよう なシステムを用いて逐次伝達法の検討を行う.図1(a) は,同軸導波管変換器を有する導波管の出力端に金属 板で作られたスリットが設置されている様子を示す. もう一つの導波管がこれに続いて設置され,図1(b) に示したように回路を構成する.座標軸は,金属板に 平行な面が xy-平面になり,導波管の中心軸に沿った 方向が z-軸になるように設ける.導波管の x-軸に沿っ た寸法を a とすると, $x = \pm a/2$  に金属壁が存在して いることになる.マイクロ波はネットワークアナライ ザから変換器の一方を経てスリットに入力され,一部 が他方の変換器を経て再びネットワークアナライザに 戻る.

本論文では、 $TE_{10}$ モードが入射している場合を考え, 導波管内において電界が y-軸方向に偏光し角周波数  $\omega$ で振動していると仮定する.このとき,y-軸方向の電界  $E_y$ を時間 t と虚数単位 i を用いて  $E_y = \Phi(z, x)e^{-i\omega t}$ と表現できる.また,マイクロ波の複素振幅  $\Phi(z, x)$ は偏微分方程式

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Phi + \omega^2 \mu_0 \epsilon \Phi = 0, \qquad (1)$$

を満たす. 透磁率は, 空間的に一様で真空での値  $\mu_0$ をもつと仮定する.スリット材料の特性は, 誘 電率  $\epsilon$ によって表現されるが, スリットの開口部 が y-軸方向に縦長に設けられていることから,  $\epsilon$  は (z, x)のみに依存する.散乱ポテンシャル v(z, x)を,  $v(z, x) = \omega^2 \mu_0 \{\epsilon(z, x) - \epsilon_0\}$ で定義すると,基礎方程 式 (1) は,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Phi + v(z,x)\Phi + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \Phi = 0,$$
(2)

と書き換えることができる.ここで, $\epsilon_0$ は真空の誘電 率である.散乱体であるスリットの電気電導率を $\sigma$ と すると,散乱ポテンシャルv(z, x)は

$$v(z,x) = \begin{cases} 0, & (z,x) \notin \texttt{``blach} \\ i\omega\mu_0\sigma, & (z,x) \in \texttt{`blach} \end{cases}, \qquad (3)$$

である.より厳密には,材料の誘電率 $\epsilon_m$ に起因する 実数部分 $\omega^2 \mu_0(\epsilon_m - \epsilon_0)$ も存在するが,マイクロ波の 周波数帯では数値的に無視することができる.

導波管の側壁は完全導体であると仮定して,側壁の 位置  $x = \pm a/2$  における複素振幅に対して

$$\Phi(z, \pm a/2) = 0,\tag{4}$$

を境界条件として課した.図1に示したような導波管 内でのマイクロ波散乱では,x-軸に関する空間反転に 関してシステムが対称性をもっているので,この対称 性を利用して境界条件を満たす定式化を行う.

2.2 界の x-軸方向に関する展開

方程式 (2) には,界の量として複素振幅  $\Phi(z,x)$  と 散乱ポテンシャル v(z,x) が現れている.これらを x-軸に関し級数展開し

$$\Phi(z,x) = \sum_{p} \varphi_p(z) e^{i(k_x + G_p)x},$$
(5)

$$v(z,x) = \sum_{p} v_p(z) e^{iG_p x},\tag{6}$$

と表現する.ここで,x-軸方向の展開領域を $|x| \le L/2$ とすると $G_p = 2\pi p/L$  ( $p = 0, \pm 1, \pm 2, ...$ ) である. 本論文では,x-軸方向のシステムサイズ L を導波管の x-軸方向の寸法 a とした場合を主に論じる.また,Lをスリットの周期に選ぶと数値計算の効率をあげ得る ことを付録で言及する.展開式(5)において基底関数 に定数 $k_x$ がパラメータとして含まれており,一般的 なフーリエ解析で用いられている基底関数に工夫が施 されている.

パラメータ k<sub>x</sub> が如何なる値であっても, 展開式 (5)

の収束性が変化しないことを付録1.に示した.この 任意性を利用して,問題に即してパラメータ k<sub>x</sub>の値 を決めると,入射波や散乱波(反射波,透過波)の展 開を効率的に行うことができる.例えば,x-軸に対 して斜めに平面波が入射している場合は,パラメー タ $k_x$ を有効に活用できる.また,空間反転 $x \rightarrow -x$ を展開係数  $\varphi_p(z)$  の指標 p の変換で表現する方法は,  $k_x = 0$ ならば  $p \rightarrow -p$  であり直観的な変換でもある が,  $k_x = \pi/a$  のときにも単純な変換  $p \rightarrow -p-1$  によ リ表現できる.図1のように, $x = \pm a/2$ に導波管の 側壁が存在し空間反転に対してシステムが対称性を有 している場合は,側壁が完全導体であるという境界条 件 (4) を満たすために  $k_x = \pi/a$  と選ぶとよい (なお,  $k_x = -\pi/a$  と選ぶことも可能). このことを付録 2. に示したが,その証明は $\cos[(k_x + G_p)a/2] = 0$ であ ることを利用している.以下に,入射波である TE10 モードを例として,  $k_x = \pi/a$  と選ぶことの利点と効 率性について説明する.

入射波である TE<sub>10</sub> モードを式 (5) で展開した場合, 複素振幅  $\Phi_{in}(z, x)$  は振幅を無次元化すると

$$\Phi_{in}(z,x) = 2\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)e^{ik_0 z},\tag{7}$$

$$k_0 = \left[\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - (\pi/a)^2\right]^{1/2},\tag{8}$$

と表現でき,二つの平面波  $e^{i(\pm \pi x/a+k_0z)}$ の重ね合わ せとみなすことができる.この入力波  $\Phi_{in}$  を展開式 (5) により展開すると,その展開係数  $\varphi_{in,p}(z)$  は,付 録 1. に示した (A·1) より得ることができ,

$$\varphi_{in,p}(z) = (\delta_{p,0} + \delta_{p,-1})e^{ik_0 z}, \qquad (9)$$

となる.ここで, $\delta_{p,q}$ はクロネッカのデルタである. この表現は,入力波を有限項で厳密に展開できるという意味で効率的な表現である.一方, $k_x \neq \pm m\pi/a$ (mは奇数)の場合には,この効率性は失われてしまう.実際に展開係数 $\varphi_{in,p}(z)$ を求めると

$$\varphi_{in,p}(z) = \frac{4\pi \cos[(k_x + G_p)a/2]}{\pi^2 - (k_x + G_p)^2 a^2} e^{ik_0 z}, \qquad (10)$$

であるが,展開の精度を高めるためにはこれらの項を 十分に大きな個数だけ加算しなければならないからで ある.更に,(10)を用いた複素振幅の表現が境界条件 (4)を満たしてはいるが, $\cos[(k_x + G_p)a/2] \neq 0$ であ ることにより付録 2.の議論が適用できない.このこと は,散乱波(透過波あるいは反射波)を級数に展開す る場合でも同じであり,  $k_x \neq \pi/a$ の場合には展開係数  $\varphi_p(z)$ に新たに拘束条件を課すなどして境界条件(4) を満たす定式化を行う必要がある.一方,  $k_x = \pi/a$ とすると付録 2. の議論が成立することより, このよ うな定式化が不要であり, 数値計算に関する効率の面 でも有利である.

2.3 逐次伝達法

展開式 (5), (6) を基礎方程式 (2) に代入すること で,偏微分方程式を,次のように2階の常微分方程式 に変換することができる.

$$\frac{d^2}{dz^2}\varphi_p(z) + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \varphi_p(z) + \sum_q [v_{p-q} - (k_x + G_p)^2 \delta_{p,q}]\varphi_q(z) = 0.$$
(11)

この常微分方程式に対して離散化手順である Numerov スキーム [9] を適用すると,微分方程式 (11) を 2 階の 差分方程式

$$a_n \Psi(z_{n+1}) + b_n \Psi(z_n) + c_n \Psi(z_{n-1}) = 0,$$
 (12)

に変換することができる [10].このとき, z-軸方向の解 析領域を区間 [ $z_0, z_N$ ] であるとして,座標値を分割幅  $h \[ r N \] 分割し \] z_n = z_0 + nh (n = 0, 1, 2, ..., N)$ と離 散化した.マイクロ波の入力端及び出力端の位置座標 である  $z_0 \] z_N$ は,散乱体であるスリットを挟んでい るならば導波管内の任意の位置に設けることが可能で ある.縦ベクトル  $\Psi(z)$ は展開係数  $\varphi_p(z)$ を成分とす るベクトル  $\Psi(z) = (..., \varphi_{-1}(z), \varphi_0(z), \varphi_1(z), ...)^T$ であり,これを今後  $\Psi(z) = \{\varphi_p(z)\}$ と略記し振幅ベ クトルと呼ぶことにする.係数行列  $a_n$ ,  $b_n$ ,  $c_n$  は, 行列

$$V_n = \left[ v_{p-q}(z_n) + \{ \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - (k_x + G_p)^2 \} \delta_{pq} \right],$$
(13)

を用いて,次のように定義される.

$$a_n = I + \frac{h^2}{12} V_{n+1},\tag{14}$$

$$b_n = -2I + \frac{5h^2}{6}V_n,$$
 (15)

$$c_n = I + \frac{h^2}{12} V_{n-1}.$$
 (16)

ここで, *I* は *V<sub>n</sub>* と同じ次元をもつ単位行列である.逐次伝達行列 *S<sub>n</sub>* を

$$\Psi(z_{n+1}) = S_n \Psi(z_n), \tag{17}$$

で定義すると,差分方程式 (12) から S<sub>n</sub> に関する漸 化式

$$S_{n-1} = -(a_n S_n + b_n)^{-1} c_n, (18)$$

を導くことができる[7].

散乱体であるスリットが空間的に局在していること から,システムの入出力端につながる領域  $z \le z_1$  及 び  $z \ge z_N$  で,散乱ポテンシャル v(z,x) = 0 となるよ うに座標を設定することが可能である.なお,入力端 は  $z = z_0$  と考えているが,後に導出する (24) を得る ためには  $z \le z_1$  とする必要がある.これらの領域は 散乱がない自由な空間であるので,常微分方程式 (11) の一次独立な二つの解を解析的に求めることができる. この解は,波数

$$k_p = [\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - (k_x + G_p)^2]^{1/2}, \qquad (19)$$

と複素定数  $\psi_p$  を用いて,  $\varphi_p(z) = e^{\pm i k_p z} \psi_p$  と表現することが可能である.以上の結果を用いて,自由な空間における一次独立な二つの振幅ベクトル  $\Psi(z_n)$ を複号 ± を用いて表現すると

$$\Psi(z_n) = \{e^{\pm ik_p z_n} \psi_p\}$$
$$= K_{\pm}^n \Psi_0, \tag{20}$$

となる.ここに, $K_{\pm}$ は対角行列であり

$$K_{\pm} = \left[ e^{\pm ihk_p} \delta_{pq} \right],\tag{21}$$

と定義されている.また, $\Psi_0 (= \{\psi_p e^{\pm i k_p z_0}\})$ は定数ベクトルである.同様に, $n \leq 1$ , $n \geq N$ において差分方程式(12)の一次独立な解を直接求めることも可能である.しかし,その解は*z*-軸の分割幅hの四次の精度で(20)に一致することが示されている[9].したがって,差分方程式(12)の一次独立な解を(20)で代用する.

散乱体が  $z_1 < z < z_N$ の間に存在する場合の散乱 問題では,マイクロ波が  $z < z_1$ の領域から z-軸の正 の方向に沿って入射していると仮定できる.この場合,  $n \leq 1$ では入射波と反射波, $n \geq N$ では透過波のみが 存在する.したがって,入射波,反射波,透過波の振 幅を成分とするベクトルをそれぞれ  $\Psi_{in}$ ,  $\Psi_{rf}$ ,  $\Psi_{tr}$ とすると

$$\Psi(z_n) = \begin{cases} K_+^n \Psi_{in} + K_-^n \Psi_{rf}, & (n \le 1) \\ K_+^{(n-N)} \Psi_{tr}, & (n \ge N) \end{cases}, (22)$$

と表現することが可能である.ここで,n < 0に対して, $K_{\pm}^{n} = (K_{\pm}^{-1})^{|n|}$ で定義する.また, $K_{\pm}^{0} = I$ である.この透過波に対する表現から逐次伝達行列 $S_{n}$ が満足すべき境界条件を求めると,未知量である透過波の振幅ベクトル $\Psi_{tr}$ を含まない形で

$$S_N = K_+,\tag{23}$$

と表現することができる.より広くは, $S_n = K_+$  ( $n \ge N$ )が成立する.なお,境界条件 (23)は,出力端につながる領域において誘電率の空間分布がz-軸方向に依存しない場合にも拡張できる一般的なものである.

境界条件 (23) と漸化式 (18) から,すべての逐次伝 達行列  $S_n$  (n < N)を決定することができる.反射波 の振幅ベクトル  $\Psi_{rf}$  は,  $\Psi(z_1) = S_0\Psi(z_0)$ を書き換 えた条件  $K_+\Psi_{in} + K_-\Psi_{rf} = S_0(\Psi_{in} + \Psi_{rf})$ から 決定でき,

$$\Psi_{rf} = -(S_0 - K_-)^{-1}(S_0 - K_+)\Psi_{in}, \qquad (24)$$

と入射波の振幅ベクトル $\Psi_{in}$ を用いて表現できる.更に,任意の位置 $z_n$ での振幅ベクトルは,入力端 $z = z_0$ における振幅ベクトルの値 $\Psi(z_0) = \Psi_{in} + \Psi_{rf}$ を用いて,

$$\Psi(z_n) = S_{n-1} \cdots S_2 S_1 S_0 \Psi(z_0), \qquad (25)$$

と表すことができる.特にn = Nとすることで,透過波の振幅ベクトル $\Psi_{tr}$ が

$$\Psi_{tr} = S_{N-1} \cdots S_2 S_1 S_0 \Psi(z_0), \qquad (26)$$

であることを導出できる.以上により,反射波及び透 過波の振幅ベクトル  $\Psi_{rf}$ ,  $\Psi_{tr}$ を,入射波の振幅ベク トル  $\Psi_{in}$ と関連づけることができた.

2.4 反射率及び透過率

入射波として TE<sub>10</sub> モードが入射している場合は,
 (9) から入射波の振幅ベクトル Ψ<sub>in</sub> は,

$$\Psi_{in} = \{ (\delta_{p,0} + \delta_{p,-1}) e^{ik_0 z_0} \}, \tag{27}$$

となる.この式が,入力端  $(z = z_0)$ における境界条件である.出力端  $(z = z_N)$ での境界条件 (23)が,逐次 伝達行列に関する条件であるのに対して,入力端での 境界条件は,振幅ベクトルに関する条件として (27)で表現されている.この入力に対する応答である,反射 波,透過波の振幅ベクトルを,それぞれ  $\Psi_{rf} = \{r_p\}$ ,  $\Psi_{tr} = \{t_p\}$ と表すことにする.

時間 t 及び空間軸 x で平均化したポインティングベ クトルの z 成分でエネルギー流束を定義する.電界 が y-軸方向のみに成分をもっておりその複素振幅が  $\Phi(z,x)$  である場合,マイクロ波の z-軸方向のエネル ギー流束  $J_z$  は,

$$J_z = \frac{1}{2\omega\mu_0} \int_{-a/2}^{a/2} \operatorname{Im}\left[\Phi^* \frac{\partial\Phi}{\partial z}\right] \frac{dx}{a},\tag{28}$$

と表現できる.ここで, *a* は導波管の幅, \* は複素共 役, Im は虚部を示す.このとき,入射,反射,透過そ れぞれのエネルギー流束 *J<sub>in</sub>*, *J<sub>rf</sub>*, *J<sub>tr</sub>*を定義式 (28) から求めると,

$$J_{in} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cos \theta, \tag{29}$$

$$J_{rf} = \sum_{p'} \frac{\operatorname{Re}[k_{p'}]}{2\omega\mu_0} |r_{p'}|^2, \qquad (30)$$

$$J_{tr} = \sum_{p'} \frac{\text{Re}[k_{p'}]}{2\omega\mu_0} |t_{p'}|^2, \qquad (31)$$

と振幅ベクトルの成分で表現することができる.ここで,Reは複素数の実部を示す.なお,Re $[k_{p'}] = 0$ となる項はエネルギーの流れを伴わず,指標p'に関する総和からも実質的に除かれる.また, $\cos \theta = (1 - k_x^2/\omega^2 \mu_0 \epsilon_0)^{1/2}$ であり,入射波であるTE<sub>10</sub>モードを構成する平面波がz-軸に対して $\theta$ だけ傾いて入射していることから得られる項である.これらのエネルギー流束を用いて,透過率Tと反射率Rをそれぞれ $T = J_{tr}/J_{in}$ 及び $R = J_{rf}/J_{in}$ ,で定義することができる.

散乱体による作用のために,反射波及び透過波の振幅ベクトル  $\Psi_{rf} \ge \Psi_{tr}$ に  $\operatorname{Im}[k_p] \neq 0$ となる p-成分を含む可能性がある.この成分は,散乱体(スリット)から離れるに従い次第に減衰するがシステムの入出力端  $z = z_0, z_N$  (n = 0, N)にまで達する可能性がある. 数値計算法として広く普及している有限要素法では, $\operatorname{Im}[k_p] \neq 0$ である成分すなわち定在波を一般的に取り除くことは難しい.このため,有限要素法で反射率や透過率を正確に求めるためには,入出力端を散乱体から十分遠くに設ける必要があり計算量が増加する傾向がある.一方,逐次代入法ではこのことに関する考慮は不要である.その理由は, $\operatorname{Im}[k_p] \neq 0$ となる定在波は,定義式(19)より  $\operatorname{Re}[k_p] = 0$ であるためにエネルギー流束を担わず,計算式(30),(31)から実質的に取り除かれているためである.

### 3. 透過率の計測と解析結果の比較

逐次伝達法の解析方法の有効性を実証的に検討する ため,金属板を材料とするスリットにマイクロ波を入 射させ透過率をネットワークアナライザで計測した. 既に図1に示したように,スリットは一対の導波管の 中央に設置されている.導波管は,EIC規格WR62に 準拠したもので,その寸法が15.8mm×7.9mmであ り,周波数帯域12.4GHzから18GHzに対応してい る.また,同軸導波管変換器はAgillent社製P281C であり,定在波比(SWR)が1.06以下であることが保 障されている.

スリットはステンレス製で抵抗率  $72 \times 10^{-8} \Omega m$  で ある.開口部の形状は,導波管の短軸(y-軸)に平行 な幅 D = 1.1 mmの縦長な長方形である.また,開 口部に挟まれた金属の柱は,幅 W = 0.5 mmで厚さ  $L_W = 0.5 \text{ mm}$ , 1.0 mmの2種類である.

数値計算に際して,x-軸方向のフーリエ展開は, システムサイズ $L \in L = a \ge 0$ ,サンプリング数  $N_G = 401$ の離散フーリエ展開で代用した.厚さ $L_W$ のスリットを挟んで,長さ $L_{edge} = 0.6 \,\mathrm{mm}$ の緩衝 領域が設けられているとして,z-軸方向の解析領域 の長さ $L_{tot} \in L_{tot} = L_W + 2L_{edge} \ge 0.6$ .更に,  $z_0 = -L_{edge}$ , $z_N = L_W + 2L_{edge} \ge 0.6$ .更に, 分割数N = 140で離散化した.分割数 $N_G$ ,Nの大 きさは,それらを各々50%変化させても透過率Tへの 影響がともに 3%以内であるように決めた.

図 2 は,スリット近傍の電界  $E_y$ の大きさを,等 高線で示した図であり,破線はスリットを構成する金 属柱である.導波管の金属壁が, $x = \pm 7.9 \text{ mm}$ に存



図 2 スリット近傍の電界強度の等高線分布.金属柱の寸 法 (a) 0.5 mm × 0.5 mm, (b) 0.5 mm × 1.0 mm

Fig. 2 Contour plots of electric field strength around slit pillars of dimensions (a)  $0.5\,\rm{mm}\times0.5\,\rm{mm},$  (b)  $0.5\,\rm{mm}\times1.0\,\rm{mm}.$ 

在しているために,この近くでの電界強度が弱くなっている.金属柱の内部にも表皮の厚さ程度マイクロ波が侵入するが,その侵入領域はわずかであり図では確認することができない.金属柱のサイズは(a)で0.5 mm×0.5 mm,(b)では0.5 mm×1.0 mmである.マイクロ波は,z < 0の領域からz-軸の正の方向に沿って入射されており,周波数はともに18 GHzである.出力側にあたる図の上部(z > 0)に等高線が少ないが,これはマイクロ波の通過率が-30 dB以下と小さなためスリットを通過する波が弱いためである.金属柱を挟んで設けられている長さ $L_{edge}$ の緩衝領域は,導波管の長さaと比較して1/10以下と短いものである.このように緩衝領域を短く設置できることが,逐次伝達法の特徴の一つである.

図 3 において,透過率 Tの周波数依存に関し, ネットワークアナライザで得た計測値(細線)と逐 次伝達法で得た理論値(太線)を比較した.図中の  $0.5 \text{ mm} \times 0.5 \text{ mm} \times 1.0 \text{ mm}$ は,用意した2 種類の金属柱のサイズである.金属柱の厚さが0.5 mmから 1.0 mmに増加すると,マイクロ波がスリットを 通過する距離が倍になるので,計測及び理論ともに透 過率 T が 10 dB 程度低くなっている.更に,計測値 と理論値との差が2 dB 程度に収まっており,周波数 依存についてはほぼ実験値を再現している.

スリットによる散乱ポテンシャルv(z,x)は,x-軸方向に空間的な周期 $L_{slit} = W + D$ をもつ.この周期を利用すると,解析領域を|x| < a/2から $|x| < L_{slit}/2$ に狭めることができ,計算に必要なメモリ容量及び時間を大幅に減少させることができる.その計算方法の詳細を付録 3.に示した.



Fig. 3 Tansmittance rate T vs. frequency f.

### 4. む す び

これまで主に個体界面の電子状態の解析に利用され ていた逐次伝達法を,電磁波の散乱に応用することを 前提として定式化し直した.更に,スリットを通過す るマイクロ波の透過率を実験及び理論により求め比較 検討した.この結果,透過率の周波数依存性をほぼ完 全に理論で再現することができ,逐次伝達法のマイク ロ波解析に対する有効性を確認できた.

本論文で論じた定式化には,フーリエ展開の基底関 数に横方向の波数パラメータ k<sub>x</sub> を追加している.こ のパラメータは制約のない自由なパラメータなので, 問題に即してその値を選ぶことが可能である.導波管 において TE<sub>10</sub> モードがスリットに入射している場合 は,二つの平面波がスリットに対して傾斜して入射し ていると考え得るので,このパラメータ k<sub>x</sub> の自由度 を活用できる例であった.

逐次伝達法がもっている特徴の一つとして,散乱に より複雑なモードが現れても境界での特別な処理を要 しないことがある.この性質は,ランダム媒質により 複雑な散乱波が発生する場合の解析などに有効である. 現在,このような場合の解析を進めており,その結果 についても報告したいと考えている.

#### 献

文

- [1] 小柴正則, "有限要素法スキームを用いたビーム伝搬法とその光導波路解析への応用",信学論(C-II), vol.J82-C-II, no.11, pp.599–608, Nov. 1999.
- [2] J. Jin and D.J. Riley, Finite element analysis of antennas and arrays, John Wiley & Sons, Hoboken, 2009.
- [3] G. Sztefka and H.P. Nolting, "Bidirectional eigenmode propagation for large refractive index steps," IEEE Photon. Technol. Lett., vol.5, no.5, pp.554– 557, May 1993.
- [4] M.D. Feit and J.A. Fleck, "Light propagation in graded-index optical fibers," Appl. Opt., vol.17, no.34, pp.3990–3998, Dec. 1978.
- [5] T. Hosono, T. Hinata, and A. Inoue, "Numerical analysis of the discontinuities in slab dielectric waveguides," Radio Sci., vol.17, no.1, pp.75–83, Jan.-Feb. 1982.
- [6] 宮本徳夫,百田美智子,安元清俊,"フーリエ級数展開 法による周期構造3次元光導波路の解析"に信学論(C), vol.J86-C, no.6, pp.591-600, June 2003.
- [7] J.A. Appelbaum and D.R. Hamann, "Self-consistent electronic structure of solid surfaces," Phys. Rev. B, vol.6, no.6, pp.2166–2177, Sept. 1972.
- [8] K. Hirose and M. Tsukada, "First-principles calculation of the electronic structure for a bielectrode junc-

tion system under strong field and current," Phys. Rev. B, vol.51, no.8, pp.5278–5290, Feb. 1995.

- [9] F.Y. Haji, H. Kobeisse, and N.R. Nassif, "On the numerical solution of Shroedinger's radial equation," J. Computational Physics, vol.16, pp.150–159, 1974.
- [10] P. Lambin and J.P. Vigneron, "Improved continued fraction treatment of the one-dimensional scattering problem," J. Phys. A (Math. Gen.), vol.14, pp.1815– 1819, 1981.
- [11] H. Kato and Y. Kanno, "Microwave absorption of catalyst in a thermal decomposition reaction by recursive transfer metohd," Jpn. J. Appl. Phys., vol.47, no.6, pp.4846–4850, 2008.
- [12] 木谷昌経,加藤初弘,"逐次伝達法によるマイクロ波散乱 の基礎検討",2008 信学ソ大(エレクトロニクス), C-1-5, Sept. 2008.
- [13] 寺澤寛一,自然科学者のための数学概論,p.151,岩波書 店,東京,1954.
- [14] C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., p.173, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2005.

# 付 録

#### 1. 級数展開の収束性

展開式 (5) の展開係数  $\varphi_p$  は,両辺に  $e^{-i(k_x+G_p)x}$ を乗じて区間 |x| < L/2 で積分することにより,次式で与えられることが分かる.

$$\varphi_p = \int_{-L/2}^{L/2} \Phi(x) e^{-i(k_x + G_p)x} \frac{dx}{L}.$$
 (A·1)

ただし,ここでは変数 z を省略して表示した.上式を 展開式 (5)の右辺に代入し,インデックス pに関する 総和を  $|p| \le M - 1$ の範囲で行ったものを  $S_M$ で表し 部分和と呼ぶことにする.このとき,部分和  $S_M$ は, 簡単な変形により

$$S_M = \int_{-L/2}^{L/2} \Phi(x') \frac{\sin\left[\frac{2\pi M}{L}(x-x')\right]}{\sin\left[\frac{\pi}{L}(x-x')\right]} \frac{dx'}{L}, (A.2)$$

と表現できる.展開式 (5) 及び展開係数 (A·1) の表現 には,ともにパラメータ $k_x$ を含むが,部分和 $S_M$ に は $k_x$ が含まれていない.更に,この部分和はフーリ エ級数に関して得られる部分和と同一である.このこ とから,フーリエ級数の収束性に関する議論 [13] と全 く同じ議論が可能である.すなわち,関数  $\Phi(x)$ が区 分的に連続である(あるいは Dirichlet 条件を満たす) なら

$$\lim_{M \to \infty} S_M = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{1}{2} [\Phi(x+\epsilon) + \Phi(x-\epsilon)], \quad (A.3)$$

が成立することを導くことが可能である.このことは,

展開式 (5) が,任意の  $k_x$  に対してフーリエ級数と同 じく区分的に連続な関数を表現できることを示してい る.したがってこの意味で,実用的なほぼすべての関 数を展開式 (5) で表現することが可能である.なお, 展開式 (5) を用いて導波管における散乱問題を取り扱 う場合は,2.2 に示したとおり  $k_x = \pi/a$  と選ぶこと が最善の選択である.

### 2. 導波管側壁における境界条件

入力波である TE<sub>10</sub> モードは (7) と表現でき,二つ の平面波  $\Phi_{in\pm}(z,x) = e^{i(\pm \pi x/a+k_0z)}$ の重ね合わせで ある.これらの平面波の一方を独立にシステムに入力 することは導波管における実験では不可能であるが, 理論的には仮想的に実現することができる.そこで,  $\Phi_{in\pm}(z,x)$ を入射させた場合に現れる (2)の理論的な 解を  $\Phi_{\pm}(z,x)$ で表すと(複合同順),実際の波  $\Phi(z,x)$ は, $\Phi(z,x) = \Phi_{+}(z,x) + \Phi_{-}(z,x)$ と二つの波を重ね 合わせることで得られる.

散乱波として透過波を考え  $\Phi_+(z,x)$  を

$$\Phi_{+}(z,x) = \sum_{p} t_{p}^{(+)} e^{i(k_{x}+G_{p})x+ik_{p}(z-z_{N})},$$
(A·4)

 $(z > z_N)$  と表現する.この波は,(27) にある  $\{\delta_{p,0}e^{ik_0z_0}\}$ による応答である.同じ(27) にある入力  $\{\delta_{p,-1}e^{ik_0z_0}\}$ による応答が $\Phi_-(z,x)$ であるが,x-軸 に関する空間反転の対称性から $\Phi_-(z,x) = \Phi_+(z,-x)$ が成立する.したがって,入力波(7) による応答であ る透過波  $\Phi_{tr}$ は, $\Phi_+(z,x)$ と $\Phi_+(z,-x)$ を重ね合わ せることにより

$$\Phi_{tr}(z,x) = \sum_{p} t_{p}^{(+)} e^{ik_{p}(z-z_{N})} 2\cos[(k_{x}+G_{p})x],$$
(A·5)

と表現することができる.ここで, $k_x = \pi/a$ であり, x-軸方向のシステムサイズ L は L = a である.

なお ,  $-(k_x + G_p) = k_x + G_{-p-1}$ という恒等式を , 対称性を表す関係式  $\Phi_-(z,x) = \Phi_+(z,-x)$ の右辺の 級数表現に用いると

$$\Phi_{-}(z,x) = \sum_{p} t_{-p-1}^{(+)} e^{i(k_x + G_p)x + k_p(z - z_N)}$$
(A.6)

を得ることができ、 $\Phi_+(z,x)$ のみならず  $\Phi_-(z,x)$ も (5)で展開可能であることが分かる.したがって、(31) に現れる  $t_p$ を  $t_p = t_p^{(+)} + t_{-p-1}^{(+)}$ と表現できる. 展開式 (A·5) は,  $\cos[(k_x + G_p)a/2] = 0$  であるこ とから  $\Phi_{tr}(z, \pm a/2) = 0$  を満たしている.すなわち, 導波管内での x-軸に関する空間反転に対して対称性な 散乱現象では,  $k_x = \pi/a$  として展開式 (5) により複 素振幅を表すことで,導波管の側壁が完全導体である という境界条件が満たされる.同じ議論により,透過 波のみならず反射波も完全導体に対する境界条件を満 足していることが分かる.

3. スリットの周期性を利用した数値計算の効率化 スリットが x-軸方向に周期  $L_{slit}$  をもち,しかも  $L_{slit}$  の自然数倍が a である場合,  $\Phi_+(z,x)e^{-ik_xx}$  が x の関数として周期  $L_{slit}$  をもつことを利用すると数 値計算の効率を大幅に改善することができる.ここで,  $\Phi_+(z,x)$  は平面波  $\Phi_{in+}(z,x) = e^{i(\pi x/a+k_0z)}$  を入力 したときに現れる (2) の解である.この理論的な背景 についてまとめる.

散乱ポテンシャルv(z,x)は、スリットの形状を反映 して決まる量なので,xの関数として $L_{slit}$ を周期と している.したがって,展開式(6)において $L = L_{slit}$ と置くことは可能である.一方, $\Phi_+(z,x)$ は,xの 関数として $L_{slit}$ を周期としないが, $\Phi_+(z,x)e^{-ik_xx}$ は $L_{slit}$ を周期としている.その理由は、基礎方程 式(2)と入力波から作った関数 $\Phi_{in+}(z,x)e^{-ik_xx}$ が,  $x \rightarrow x + L_{slit}$ という変換に対してともに不変である こと,及び, $L = L_{slit}$ としても(A·5)が成立するこ とから透過波(より一般には散乱波)が $x = \pm a/2$ に おいて完全導体の境界条件を満足するからである.方 程式(2)の解は、境界条件が決まれば一意に決まるの で, $L = L_{slit}$ と制限したとしても解が得られたなら それが求める解である.

実際に  $\Phi_+(z,x)e^{-ik_xx}$  が, 変数 x の関数として周 期  $L_{slit}$  をもっていることを数値的に確かめた結果が 図 A·1 である(計算条件は,図 2(a)のときに用いた ものと同じであり L = a とした). このことは,結晶 中の電子波の状態である Bloch 状態[14] と類似した 状態にマイクロ波があることを示している.実験で使



図 A·1  $\Phi_+(z,x)e^{-ik_xx}$ の等高線図. x-軸方向に,ス リットの周期  $L_{slit}$ と同じ周期性をもつ.

Fig. A-1 Contour plot of  $\Phi_{+(z,x)}e^{-ik_xx}$ , which has periodicity equivalent to slit period  $L_{slit}$  along x-axis.

用したスリットは図に破線で示したようなものであり, 議論の前提 ( $a/L_{slit} =$ 自然数)が厳密には成立しな い.しかし,その影響は図 A·1 でほとんど現れない ほどにわずかである.

システムサイズ  $L \in L = L_{slit}$ として透過波を (A·5) で表現し,エネルギー流束の表現 (28) に代入すると,

$$J_{tr} = \sum_{p,q} \operatorname{Im} \left[ \frac{t_p^{(+)*} t_q^{(+)} i k_q}{\omega \mu_0} \int_{-a/2}^{a/2} \left\{ \cos[G_{q-p} x] + \cos[(2k_x + G_{p+q})x] \right\} \frac{dx}{a} \right],$$
(A·7)

を得る.ここで, $\cos[G_{q-p}x]$ に関する積分からクロ ネッカのデルタ  $\delta_{pq}$ が得られる.また, $k_x = \pi/a$ ,  $G_p = 2\pi p/L_{slit}$ , $a/L_{slit} = N_{slit}$ (自然数)であるこ とから, $\cos[(2k_x + G_{p+q})x]$ に関する積分は消失する. したがって,エネルギー流束に関する表現として

$$J_{tr} = \sum_{p} \frac{\text{Re}[k_{p}]}{\omega\mu_{0}} |t_{p}^{(+)}|^{2}, \qquad (A.8)$$

が得られる.この式は,入力波の振幅ベクトルと して (7) を用いる代わりに,平面波  $\Phi_{in+}(z,x) = e^{i(\pi x/a+k_0 z)}$  に対応する振幅ベクトル  $\Psi_{in+} = \{\delta_{p,0}e^{ik_0 z_0}\}$ を入力として求めた係数  $t_p^{(+)}$ を用いて もエネルギー流束を求めることが可能であることを示 している.このこと自体は,数値計算の効率化と直接 的には関係していない.しかし,展開式 (A·4) (ある いは (5))においてシステムサイズ L を  $L = L_{slit}$  と できることと組み合わせると数値計算を効率化できる. その理由は,解析する x-軸方向の領域を狭くすること ができるからである.なお,入射波のエネルギー流束 は,(29)で求めることができる.

実際にシステムサイズを $L = L_{slit}$ , x-軸の分割数  $N_G$ を $N_G = 41$ として, 展開係数 $t_p^{(+)}$ から求めた透 過率Tを, L = a,  $N_G = 401$ として求めた図 3 の値 と比較した.その結果,両者の違いは 1%以下とわず かであった.このように散乱体(スリット)の周期性 を利用すると,分割数 $N_G$ を図 3 を求めたときのほ ぼ 1/10 にすることができ,計算に要するメモリと時 間を大幅に削減することができる.

(平成 22 年 4 月 11 日受付, 5 月 19 日再受付)



### 加藤初弘(正員)

1987 北大・工・応用物理学専攻博士課 程了.1987(株)東芝入社.総合研究所勤務.1999 山梨大学工学部助教授(現,准 教授).デバイス物理・システム設計などに 関連してマイクロ波現象などを研究.



## 木谷 昌経

2007 山梨大・工卒.同年,同大大学院修 士課程進学.現在,博士課程に在籍.マイ クロ波の医用工学的応用を研究.



# 加藤 初儀

1984 北大・工・応用物理学専攻修士課程 了.1998 博士(工)を北大より取得.日本 電気(株)半導体事業本部勤務を経て,現 在苫小牧高専教授.電磁波やフォノンなど を含め広く散乱現象に興味をもつ.